

性能特点

- 工作频段：2.7GHz~3.5GHz
- 饱和输出功率：56dBm
- 功率增益：36dB
- 功率附加效率：50%
- 封装形式：管壳封装 25 mm×45mm×5.5mm
- 工作温度：-55℃~+85℃

产品简介

采用 GaN HEMT 管芯芯片。工作频率范围覆盖 2.7GHz~3.5GHz，典型饱和输出功率 56dBm，典型功率增益 36dB，适用于脉冲工作模式。可用于微波收发组件等微波系统中。

电参数 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_d = 48\text{V}$, $V_g = -5\text{V}$) 脉宽 (1ms) 占空比 (15%)

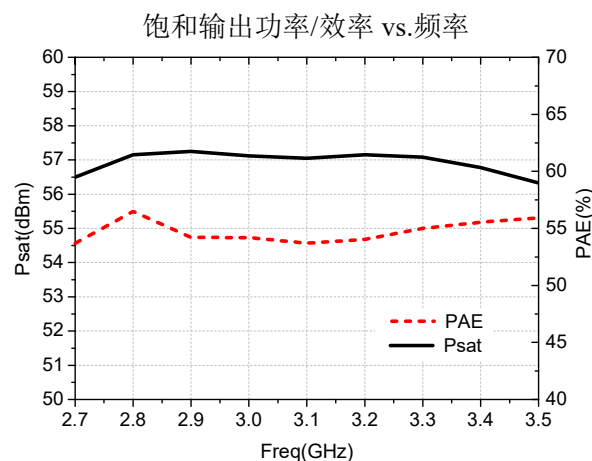
指标	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	f	2.7~3.5			GHz
饱和输出功率	Psat		56		dBm
功率增益	Gp		36		dB
功率增益平坦度	ΔG_p			1	dB
功率附加效率	PAE		50		%
工作电流	Id		16		A

注：测试条件 $V_d = +48\text{V}$, $V_g = -5\text{V}$, $P_{in} = 20 \pm 1\text{dBm}$, $T = 1\text{ms}$, $D = 15\%$ 。

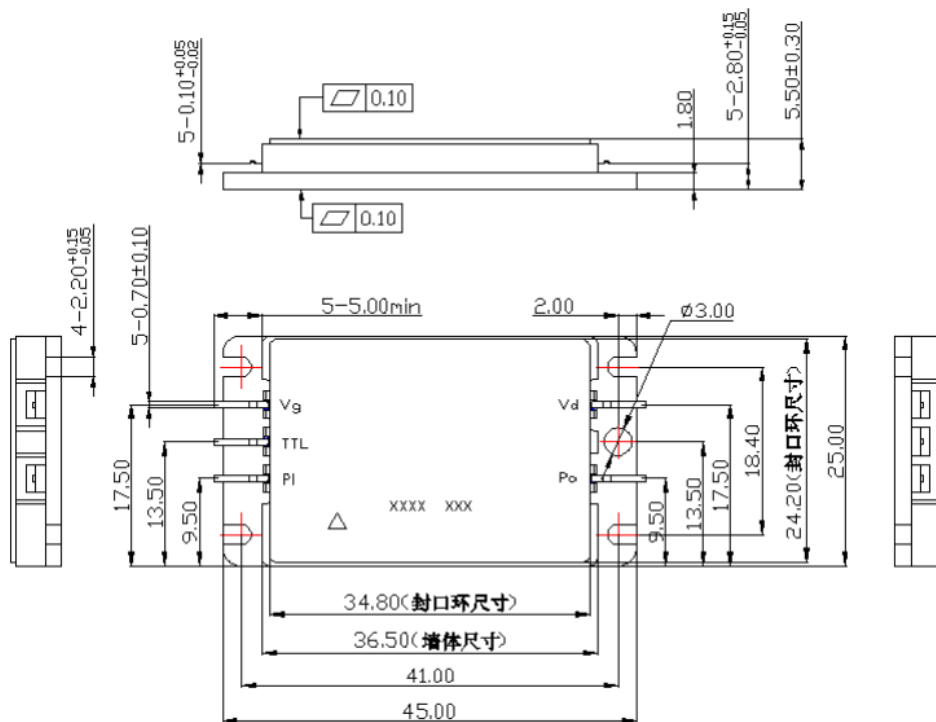
使用极限参数 ($T_A = +25^\circ\text{C}$)

指标	符号	极限值	单位
漏源电压	V_d	+60	V
栅源电压	V_g	-10	V
输入连续波功率	RF_{in}	+25	dBm
存储温度	T_{stg}	-55~+125	℃

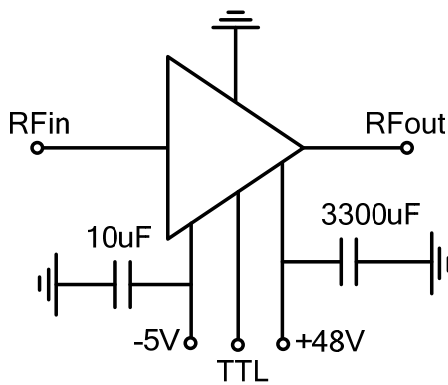
典型曲线 ($T_A = +25^\circ\text{C}$)



外形尺寸 (单位: mm)



典型使用电路图



注意事项

- 1) 该产品内置负控正保护电路;
- 2) 使用时将器件紧贴盒体底部用螺丝固定, 建议器件底部使用铝箔片以改善微波接地特性, 引出端应齐平或略高于焊接平面;
- 3) 使用过程中注意散热, 壳温过高会导致器件性能恶化, 缩短使用寿命;
- 4) 本产品属于静电敏感器件, 储存和使用中注意防静电, 仪器、设备等应良好接地;
- 5) 不能触摸器件引线;
- 6) 辐照特性: 本器件为辐照不敏感产品;
- 7) 有问题请与供货商联系。



静电敏感性器件
请注意静电防护